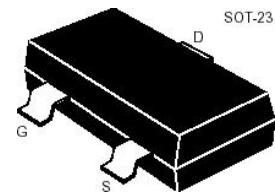


SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)



N-Channel Enhancement-Mode MOS FET With ESD

N 沟道增强型带静电保护 MOS 场效应管

■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	BV_{DSS}	60	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	V_{GS}	± 20	V
Drain Current (continuous) 漏極電流-連續	I_{DR}	300	mA
Drain Current (pulsed) 漏極電流-脉冲	I_{DRM}	500	mA

■ THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

Characteristic 特性	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 $T_A=25^\circ\text{C}$ 環境溫度為 25°C Derate above 25°C 超過 25°C 遞減	P_D	225	mW
Thermal Resistance Junction to Ambient 热阻	$R_{\Theta JA}$	1.8	$\text{mW}/^\circ\text{C}$
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T_J, T_{stg}	150°C, -55 to +150°C	$^\circ\text{C}/\text{W}$

■ DEVICE MARKING 打標

2N7002K=72K

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

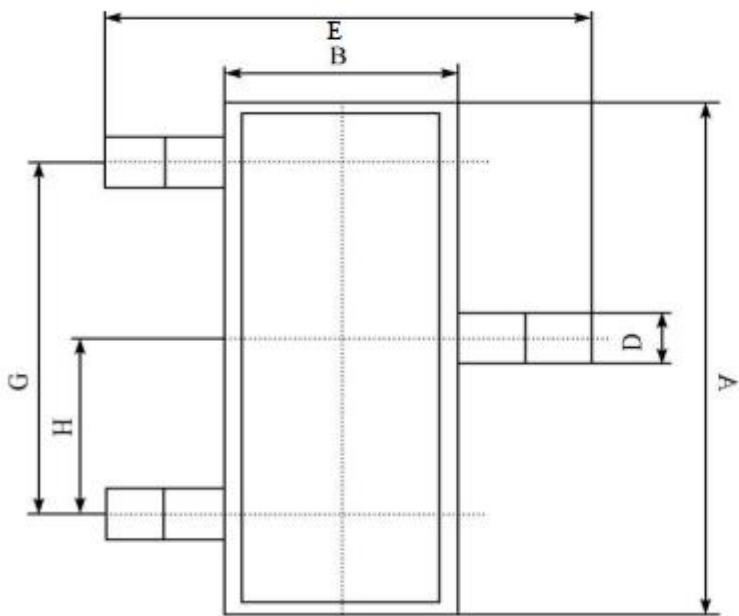
($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓($I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$)	BV_{DSS}	60	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓($I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=V_{DS}$)	$V_{GS(\text{th})}$	1.0	—	2.5	V
Drain-Source On Voltage 漏極-源極導通電壓($I_D=50\text{mA}, V_{GS}=5\text{V}$) ($I_D=500\text{mA}, V_{GS}=10\text{V}$)	$V_{DS(\text{ON})}$	—	—	0.375 3.75	V
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降($I_{SD}=200\text{mA}, V_{GS}=0\text{V}$)	V_{SD}	—	—	1.5	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流($V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=\text{BV}_{DSS}$)	I_{DSS}	—	—	1	μA
Gate Body Leakage 柵極漏電流($V_{GS}=\pm 10\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$) ($V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$)	I_{GSS}	—	—	± 1 ± 10	μA
Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻($I_D=500\text{mA}, V_{GS}=10\text{V}$) ($I_D=50\text{mA}, V_{GS}=5\text{V}$)	$R_{DS(\text{ON})}$	—	—	2.8 3.2	Ω
ESD Rating 静电保护	ESD	2000V HBM			

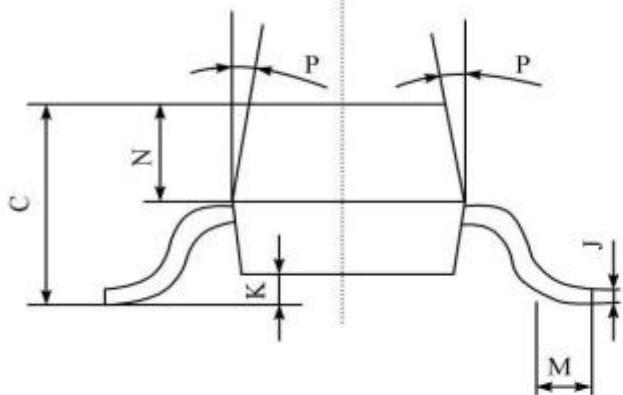
1. FR-5=1.0×0.75×0.062in.
2. Alumina=0.4×0.3×0.024in. 99.5%alumina.
3. Pulse Width≤300 μs ; Duty Cycle≤2.0%.

■ DIMENSION 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



代碼	範圍(單位:mm)
A	2.80~3.00
B	1.20~1.40
C	0.90~1.10
D	0.30~0.50
E	2.20~2.60
G	1.80~2.00
H	0.90~1.00
J	0.08~0.18
K	0.02~0.12
M	≥0.22
N	0.50~0.70
P	6°~10°



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for MOSFET category:

Click to view products by Yongytai Electronics manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [MCH3443-TL-E](#) [MCH6422-TL-E](#) [NTNS3A92PZT5G](#) [IRFD120](#) [IRFF430](#) [JANTX2N5237](#) [2N7000](#) [AOD464](#)
[2SK2267\(Q\)](#) [2SK2545\(Q,T\)](#) [405094E](#) [423220D](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [614234A](#) [715780A](#) [SSM6J414TU,LF\(T](#) [751625C](#)
[IPS70R2K0CEAKMA1](#) [BSF024N03LT3 G](#) [PSMN4R2-30MLD](#) [TK31J60W5,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#)
[EFC2J004NUZTDG](#) [FCAB21350L1](#) [P85W28HP2F-7071](#) [DMN1053UCP4-7](#) [NTE2384](#) [NTE2969](#) [NTE6400A](#) [DMC2700UDMQ-7](#)
[DMN2080UCB4-7](#) [DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#) [SSM6P54TU,LF](#) [DMP22D4UFO-7B](#) [IPS60R3K4CEAKMA1](#)
[DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#) [STF5N65M6](#) [IRF40H233XTMA1](#) [IPSA70R950CEAKMA1](#) [IPSA70R2K0CEAKMA1](#) [STU5N65M6](#)
[C3M0021120D](#) [DMN6022SSD-13](#)